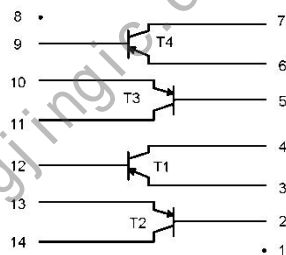


# HJ622A /MXT622A PNP 三极管阵列

## 一、概述

HJ622A / MXT622A 是三极管阵列集成电路，该电路是由四个 PNP 硅三极管组成。它既具有紧密的电匹配和良好的热匹配性能，而且一致性和均匀性比分立管更好。能在-55~+125℃的温度范围内保持良好的性能，通道绝缘电阻大于  $10^{10}\Omega$ 。

## 二、电原理图

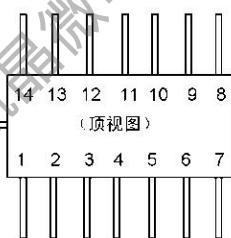


## 三、封装形式及引出端功能

### 1. 封装形式

采用 F14-01B 陶瓷扁平外壳封装

外形尺寸见附录一图 9。



### 2. 引出端功能

引出端功能如下表

引脚号	1	2	3	4	5	6	7
功能	NC	b <sub>2</sub>	e <sub>1</sub>	c <sub>1</sub>	b <sub>3</sub>	e <sub>4</sub>	c <sub>4</sub>
引脚号	8	9	10	11	12	13	14
功能	NC	b <sub>4</sub>	e <sub>3</sub>	c <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	c <sub>2</sub>

## 四、绝对最大额定值

单管耐压 $BV_{CEO}$	-50V	单管驱动电流 $I_{EM}$	400mA
工作温度范围	-55~+125℃	耗散功率	600mW
结温	+175℃		

## 五、电特性 (除非另有说明, $T_A=+25^\circ\text{C}$ 。)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电流放大倍数	$h_{FE}$	$V_{CE}=-5V, I_E=200mA$	60	150		
集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=0.1mA$			-50	V
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1mA$			-45	V
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-45V$			5	$\mu A$
集电极-发射极截止电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=-3V$			10	$\mu A$
集电极-发射极的饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_B=80mA, I_E=400mA$		-0.2	-1.3	V
特征频率*	$f_T$	$V_{CE}=10V, I_C=3mA$	200			MHz

注：\*设计保证